塩水膜環境における**carbon-aluminium** ガルバニック腐食の数値解析

> *○増谷浩一(東工大) 大西有希(東工大) 天谷賢治(東工大)*



研究背景

- 近年,自動車の軽量化のために,車体にCFRPやアルミニウムなどの軽量材料を適材適所に用いるマルチマテリアル化が進んでいる.
- 異種の導電性材料の接合部に海水や融雪剤などに起因した塩水膜環境が形成されると、ガルバニック腐食の発生が懸念される。

Fig. multi-material designed vehicle 上部モジュールがCFRP,下部モ ジュールがアルミニウムで構成される. BMW Japan Corp.から引用 http://www.bmw.co.jp/jp/ja/insights/cor poration/bmwi/concept.html





研究背景

- 腐食に対して適切な対策を施すためには、どのように腐食 するか評価することが必要。
- これまでは促進試験装置やテストコースによる実験的手法による評価が行われてきたが、高コストと長い実験時間がネックとなってきた。

⇒数値解析による低コストで高速な評価が必要とされている.

Fig. multi-material designed vehicle 上部モジュールがCFRP,下部モ ジュールがアルミニウムで構成される. BMW Japan Corp.から引用 http://www.bmw.co.jp/jp/ja/insights/cor poration/bmwi/concept.html







電気泳動 物質拡散

TDK

Pursuing Excellence

太散 化学反応

計算において満足9へざ案件 質量保存 電気的中性 移動境界(腐食による金属の形状変化)

	K. L. Heppner <i>et</i> al. ^[2]	S. Scheiner <i>et al</i> . ^[3]
マルチフィジックス問題	0	Х
電気的中性の成立	0	X(イオン1種のみ)
物質量保存の成立	△(メッシュ依存)	\bigcirc
形状変化の考慮	X	0

これらの要素を全て考慮した局部腐食シミュレータ を開発してきた.

[2] K. L. Heppner *et al.* Corrosion Eng Sci Tec, Vol. 41, No. 2, pp. 110–121, 2006.
[3] S. Scheiner *et al.* CMAME Vol. 198, No. 37-40, pp. 2898 – 2910, 2009.



実際の車両で発生が懸念される <u>塩水膜下carbon-aluminiumガルバニック腐食を</u> 再現するシミュレータの開発を目的とする.

目次

- ・ 想定するGC/AIガルバニック腐食現象のメカニズム
- 数值解析手法
- 実験によるシミュレータの検証



TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

GC/AIガルバニック腐食の メカニズム



TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY



グラッシーカーボン板(GC)と純アルミニウム板(AI)
 の接合部に塩水膜が張られた場合を考える.



Air





TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 液膜内にはNaCIが電離して Na⁺ イオンと Cl⁻ イオンが 存在する.
- 水膜の厚さは1~2mm程度と薄いため,液膜内には酸素が豊富に溶存している.





TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

 AIはGCより低い自然電位を持つため、AI表面では酸化反応により Al³⁺が, GC表面では還元反応によりOH⁻が発生する.

Chemical Reactions:

- $: Al \rightarrow Al^{3+} + 3e^{-}$ on Al (anodic reaction)
- : $0_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$ (cathodic reaction) on GC

Air



- 発生したOH-およびAl³⁺はNa⁺およびCl-によって電気的に中和される.これらのイオンが溶液内における電流のキャリアとなる.
- 発生したOH-によってGC上の溶液は塩基性になる.



Al³⁺の加水分解によってAl上の溶液は酸性となる.

Chemical Reactions:

 $Al^{3+} + H_2O \rightleftharpoons AlOH^{2+} + H^+$, $Al^{3+} + 2H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_2^+ + 2H^+$, $Al^{3+} + 3H_20 \rightleftharpoons Al(OH)_3\downarrow + 3H^+, \qquad Al^{3+} + 4H_20 \rightleftharpoons Al(OH)_4^- + 4H^+.$

 水酸化アルミニウムAl(OH)₃は白い沈殿物となってAl上 に堆積する.



数值解析手法



E TECHNOLOCY

12

数値解析手法の概略

- 腐食の支配方程式を境界 条件の元で有限体積法を 用いて解くことで,腐食 を再現する.
- 支配方程式は3ステップ
 に分けて計算する

ТПК

Pursuing Excellence









Φ	Electrostatic potential [V]
F	Faraday's constant [F m ⁻¹]
3	Permittivity [(Ωm) ⁻¹]
Z _i	Charge number of ion i
C _i	Molar concentration of ion i [mol m ⁻³]
D _i	Diffusion coefficient of ion i [m ² s ⁻¹]
U _i	Mobility of ion i [m ² mol J ⁻¹ s ⁻¹]



2つの方程式を弱連成で解く



TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY



<u>1) 電場のラプラス方程</u>	式
(静電場解析)	

$$abla^2 \phi = 0$$
 $\stackrel{\smile}{\equiv} 0$

ar



Φ	Electrostatic potential [V]
F	Faraday's constant [F m ⁻¹]
3	Permittivity [(Ωm) ⁻¹]
Z _i	Charge number of ion i
C _i	Molar concentration of ion i [mol m ⁻³]
D _i	Diffusion coefficient of ion i [m ² s ⁻¹]
U _i	Mobility of ion i [m ² mol J ⁻¹ s ⁻¹]

$$\frac{\partial c_{i}}{\partial t} = -\nabla \cdot (-z_{i}u_{i}C_{i}F\nabla\phi - D_{i}\nabla C_{i}) + E_{i}(C_{i})$$

電気泳動項 物質拡散項 化学反応項
= N_{i} : モル流束密度

2つの方程式を弱連成で解く



TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY







金属や空気に囲まれた溶液内が解析領域である.

溶液内にはイオンなどの化学種が存在する.

金属イオンの加水分解などの化学反応が起こる.









絶縁物に対して設定

- 静電場解析:電流密度0の境界条件を与える.
- 物質移動解析:モル流束密度0の境界条件を与える.



解析領域および境界条件





- 静電場解析:電流密度0の境界条件を与える.
- 物質移動解析:酸素濃度一定の境界条件を与える.
 (二酸化炭素濃度一定)









- 静電場解析:分極曲線から得られる電流密度を与える.
- 物質移動解析:分極曲線から得られた電流密度に拘束されたモル流束密度を与える.(金属上の酸化還元反応)





- 実験で取得した電位-電流密度データをtafel曲線で補間.
- 本研究では電位-電流密度曲線がpHのみに依存するとし



解析領域の離散化手法

PursuingExcellence

- 本手法で採用した有限体積法は質量保存を満足する.
- 現在は二次元解析であり,解析領域を分割するコントロール ボリュームとして直交等間隔な正方形ピクセルを用いる.





(腐食速度)×(表面積)×(電流密度)

▲ 表面積は正確に見積もる必要がある.



セルにおける体積分率(VOF:volume of fluid) を用いて滑らかな境界線を再現する.



滑らかな境界線を引く方法

- 1つのセルを8個の三角
 形に分割し,9個の頂点
 を設定.頂点のVOFを,
 その頂点が属するセルの
 VOFの平均値とする.
- 各頂点のVOFを三角形の 辺上で線形補間して,三 角形内にVOF=0.5となる 等高線を引くことにより セルのサイズ以上の滑ら かな境界線を引く.







静電場解析

電場の支配方程式を解くことでセル間を流れる電流密度を

求める解析ステップ

• 支配方程式はラプラス方程式

$$\kappa \nabla^2 \phi = \nabla J = 0$$

未知数をセルの電位とし,各セルに流入する電流の合計
 を示す残差式を立てる.

$${}^{j}\boldsymbol{r} = \sum_{k \in F} \kappa A_k \left. \frac{\partial \phi}{\partial n} \right|_k$$

 適当に仮定した電位分布を初期値とし,残差r=0と境界 条件を満たすように電位分布を修正することによって支 配方程式を満足する電位分布を求める.(ニュートン-ラフソン法)



TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

物質移動解析

物質移動の支配方程式の電気泳動項と拡散項による濃度の時間変化を計算するステップ.



モル流東密度 $N_i(= -z_i u_i C_i F \nabla \phi - D_i \nabla C_i)$ と電流密度Jとの間 に以下の拘束条件を課すことで電気的中性を満足する.

$$J = F \sum_{i \in \mathbb{I}} z_i N_i$$

κ : electrical conductivity*J* : current density

未知数をN_iとして上記2式から残差の式を立て,ニュート ン-ラフソン法を用いて解く.



TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

化学反応解析

溶液内の化学反応による各化学種濃度の変化量を計算する ステップ

- 溶液内の化学反応は充分に速いとして、1タイムステップで濃度が化学平衡式を満足すると仮定している。
- セルごとに独立して計算を行う.



化学反応解析

前記の化学反応に対応する以下の方程式を連立させて解く.

 $\frac{([\text{AlOH}^{2+}] - x_1)[\text{H}^+]_a}{[\text{Al}^{3+}] + x_1 + x_2 + x_3 + x_4} = K_1$ $\frac{\left([\mathrm{Al}(\mathrm{OH})_{2}^{+}] - x_{2}\right)\left[\mathrm{H}^{+}\right]_{a}^{2}}{[\mathrm{Al}^{3+}] + x_{1} + x_{2} + x_{3} + x_{4}} = K_{2}$ $\frac{([Al(OH)_3] - x_3)[H^+]_a^3}{[Al^{3+}] + x_1 + x_2 + x_3 + x_4} = K_3$ $\frac{([\mathrm{Al}(\mathrm{OH})_{4}^{-}] - x_{4})[\mathrm{H}^{+}]_{a}^{4}}{[\mathrm{Al}^{3+}] + x_{1} + x_{2} + x_{3} + x_{4}} = K_{4}$ $[H^+]_a([OH^-] + x_5) = K_w$

5元5次方程式となり, 解析的に解くのは困難. そのため数値的に解く.



TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

検証例題によるシミュレーターの検証 GC/AIガルバニック腐食



29



- 試験片は電極となる 板状のGCと純アル ミニウム(A1050)の 一辺をコーキング剤 で接着したもの.
- 試験片上にNaCl溶 液膜を張り,電極間 を電流計で導通させ て腐食を発生させた

Pursuing Excellence

ΤΟΚ

試験片写真(TOP VIEW)





50 mm

pHガラス電極

30



• 実験条件

ΤΟΚΥ

- 腐食時間:48時間
- 液膜厚さ:2 mm
- 電極面積: 40×50 mm²
- NaCI濃度:0.5 wt%

試験片写真(TOP VIEW)



50 mm

pHガラス電極

湿度維持と二酸化炭 素除去について 試験片を水酸化ナト リウム溶液と共にア クリルケース内に設 置した.

Pursuing Excellence





- 測定
 - 腐食電流時刻歴
 - pH時刻歴(ガラス電 極にて,各電極上で 1点ずつ)
 - 試験片のインターバ ル写真(1時間に1 枚)
 - pH分布(pH試験紙)

※短時間の腐食であるため,腐食による金属の形状変化は比較しない.





<u>試験片写真(TOP VIEW)</u>



50 mm

32

TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

pHガラス電極

直解析概要

<u>幾何形状</u>







酸とアルカリの境界に水酸化アルミニウムが生じる様子を再現することができたが、境界位置は再現できなかった。

Pursuing Excellence



• アノード側の誤差は約0.7,カソード側の誤差は約1.2となった.

- pHが再現できない原因
 - ➤ 二酸化炭素が完全に除去できていなかった可能性(GC上)
 - ▶ 塩酸の蒸発を考慮していないこと(AI上)
 - ▶ 沈殿物の扱い
 - ▶ 考慮する化学反応の速度,種類,平衡定数の値など



- オーダーは一致したが,実験における電流値の変化は再現できなかった.
 - 実験において開始直後に電流が大きく下がるのは, GC近傍の酸素の消費によって酸素の拡散律速状態によるものか.
 - 実験における20時間までの電流の上昇は酸性溶液のGC側への侵入によるものか.

37

IUK



赤いセルがアルミニウム,青いセルが溶液とカソードを示す. 黒い線が固体と溶液の境界線を示す.



※短い時間でも変化がわかりやすいように 金属密度を低く設定した.



TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY



- ガルバニック腐食を再現する腐食シミュレーターを開発した.
- シミュレーターにおいて以下に示す要素を考慮した.
 * 電気泳動, *物質拡散,
 * 化学反応, *移動境界,
 - * 質量保存, * 電気的中性.
- 検証のためにGC/AIガルバニック腐食実験を行い、シミュレーターによって溶液内の状態(pH,沈殿の分布および腐食電流)を定性的に再現できることを確認した。
- 今後の課題
 - 腐食電流の精度を上げる.
 - 腐食による金属形状の変化を再現する.

